

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成24年1月19日(2012.1.19)

【公表番号】特表2011-508967(P2011-508967A)

【公表日】平成23年3月17日(2011.3.17)

【年通号数】公開・登録公報2011-011

【出願番号】特願2010-539572(P2010-539572)

【国際特許分類】

H 01 L 51/30 (2006.01)

H 01 L 29/786 (2006.01)

H 01 L 51/05 (2006.01)

H 01 L 51/40 (2006.01)

C 07 F 7/08 (2006.01)

【F I】

H 01 L 29/28 2 2 0 A

H 01 L 29/78 6 1 8 B

H 01 L 29/78 6 1 8 E

H 01 L 29/28 1 0 0 A

H 01 L 29/28 2 5 0 H

H 01 L 29/28 3 1 0 A

C 07 F 7/08 W

【手続補正書】

【提出日】平成23年11月18日(2011.11.18)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

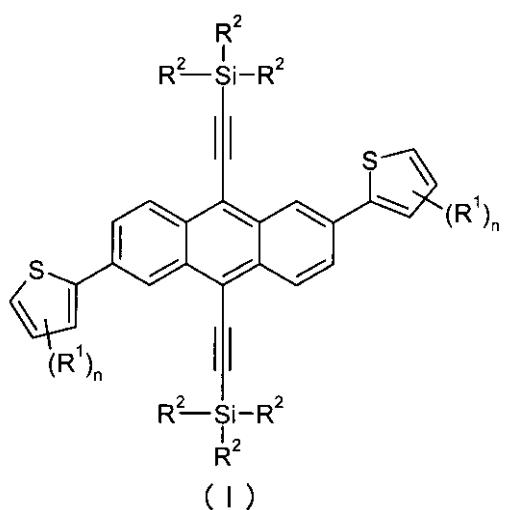
【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

(a)式(I)の低分子半導体

【化1】



(式中、

それぞれの R^1 は独立して、アルキル、アルコキシ、チオアルキル、ヒドロキシアルキル、ヘテロアルキル、アルケニル、アルキニル、アリール、アラルキル、ハロ、ハロアルキル、トリアルキルシリル、チエニル、ホルミル、アシル、アルコキカルボニル、カルボキシ、アミノカルボニル、アミノスルホニル、又はこれらの組み合わせであり、

それぞれの n は独立して、0、1、2、又は3に相当する整数であり、及び

それぞれの R^2 は独立して、アルキル、アルコキシ、アルケニル、アリール、ヘテロアリール、アラルキル、ヘテロアルキル、ヘテロアラルキル、又はヒドロキシアルキルである)、

(b) 絶縁ポリマー、並びに

(c) 有機溶媒、

を含むコーティング組成物であって、

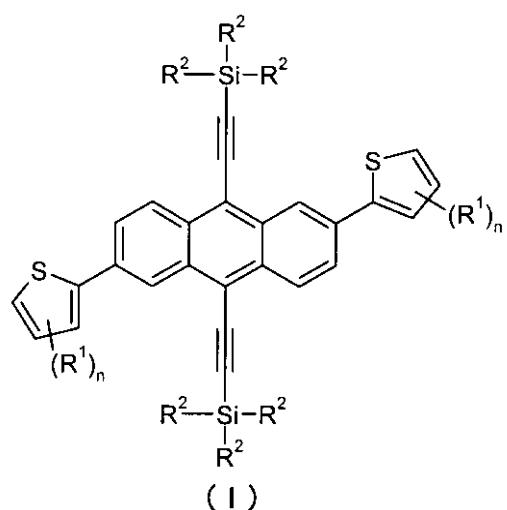
式(I)の低分子半導体及び前記絶縁ポリマーがそれぞれ、前記コーティング組成物の総重量を基準として、少なくとも0.1重量%の溶解度を有する、

コーティング組成物。

【請求項2】

(a) 式(I)の低分子半導体

【化2】



(式中、

それぞれの R^1 は独立して、アルキル、アルコキシ、チオアルキル、ヒドロキシアルキル、ヘテロアルキル、アルケニル、アルキニル、アリール、アラルキル、ハロ、ハロアルキル、トリアルキルシリル、チエニル、ホルミル、アシル、アルコキカルボニル、カルボキシ、アミノカルボニル、アミノスルホニル、又はこれらの組み合わせであり、

それぞれの n は独立して、0、1、2、又は3に相当する整数であり、及び

それぞれの R^2 は独立して、水素、アルキル、アルコキシ、アルケニル、アリール、ヘテロアリール、アラルキル、ヘテロアルキル、ヘテロアラルキル、又はヒドロキシアルキルである)、並びに

(b) 絶縁ポリマー、

を含む半導体層を含む半導体デバイス。